

REC'D **0 8 APR 2005**WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 5 FEV. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b) Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr





Pour vous informer ; INPI DIRECT

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

(13/1/13) N° 11354*03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

N° 11354*03

(FINTINGEO) 0 825 83 85 87 page 1/2 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Télécopie: 33 (0)1 53 04 52 65 Réservé à l'INPI NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE REMISEDES PIEDES N 2004 À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE 75 INPI PARIS 34 SP SNPE 0400720 SERVICE PROPRIETE INDUSTRIELLE Nº D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 12 Quai Henri IV 2 7 JAN: 2004 75004 PARIS DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE FRANCE PAR L'INPI Vos références pour ce dossier (facultatif) B. 1235 Confirmation d'un dépôt par télécopie N° attribué par l'INPI à la télécopie Cochez l'une des 4 cases suivantes 2 NATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet 16 Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire П No Date Demande de brevet initiale No Date ou demande de certificat d'utilité initiale Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale Date TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Microsystème pyrotechnique et procédé de fabrication d'un microsystème. Pays ou organisation DÉCLARATION DE PRIORITÉ No Date | | **OU REOUÊTE DU BÉNÉFICE DE** Pays ou organisation LA DATE DE DÉPÔT D'UNE N٥ Date | | | | | | | **DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** Pays ou organisation Ν° Date | | | | | | | | S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» E DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) 15 Personne morale Personne physique Nom SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique Société anonyme N° SIREN Code APE-NAF 12 Quai Henri IV Rue Domicile OH Code postal et ville 7 15 10 10 14 | PARIS siège **FRANCE** Pays Nationalité FRANCAISE N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)

S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



				(**************************************	
R	REMISEDES PIÈCES I	N 20 D4 Béservé à l'INPI			
D		PARIS 34 SP			
U	IEU YO MAFTE	AKIO 34 SP		•	
1	10 Pater 1 Pater 1	0400720	•		
	I° D'ENREGISTREMENT IATIONAL ATTRIBUÉ PAR	A 1445			
10000		The latest and the la		DB 540 W / 210	
	MANDATAIR	E (s'il y a lieu)			
	Nom				
	Prénom				
	Cabinet ou Sc	ociété	SNPE		
			0.41		
Г	N °de pouvoir	permanent et/ou			
	de lien contra	ctuel	LC018E		
			100		
		Rue	12 Quai Henri IV		
	Adresse	Code postal at villa			
		Code postal et ville	17 5 10 10 14 1 PARIS		
-	Alo de tili-i-	Pays	FRANCE		
L	N° de téléphor				
_	N° de télécopi				
2000		onique <i>(facultatif)</i>			
Z	I inventeur (Les inventeurs sont nécessairement de	es personnes physiques	
	Les demandeu	rs et les inventeurs	Oui		
22.02	sont les même		Non: Dans ce cas remplir le form	ulaire de Désignation d'inventeur(s)	
E	RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour une demande de bre	vet (y compris division et transformation)	
		Établissement immédiat	X	ove G compile division et transformation)	
		ou établissement différé			
	Doinmant date				
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)			Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	※ Non		
	RÉDUCTION D	OU TAUX	Uniquement name to a name		
	DES REDEVAN		Uniquement pour les personnes physiq	ues	
			Obtanue antériourement à ce dénée au	e invention (joindre un avis de non-imposition)	
			Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
D'you	cfourness.		The second of th	(masquer sa reference): AG	
<u></u>	ET/OU D'ACID	DE NUCLEOTIDES ES AMINÉS	Cochez la case si la description contient	une liste de séquences	
	Le support élect	ronique de données est joint			
	La déclaration d	le conformité de la liste de			
	sequences sur	Support papier avec le			
		lique de données est jointe			
	Si vous avez ut	tilisé l'imprimé «Suite»,	4		
		nbre de pages jointes	1		
		J DEMANDEUR	1.1/1/1	VISA DE LA PRÉFECTURF	
	OU DU MANDA			OU DE L'INPI	
		é du signataire)	III augll	O DE LIMIT	
	P.G.1020	â			
		Ć	Carol WALIGORSKI		
_		Chef	du service Propriété Industrielle	1	
_			-		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

requête en délivrance

Page suite	No.	1.	. /2.	٠.	BR/sum
------------	-----	----	-------	----	--------

REMISEDES PIÈGES IN DATE 75 INPLP LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	Réservé à l'INPI J 2004 ARIS 34 SP 0400720		DB 829 ② W /2101
	our ce dossier facultatif		
DÉCLARATIO OU REQUÊTE LA DATE DE		Pays ou organisation Date L L L L L N° Pays ou organisation Date L L L L N° Pays ou organisation Date L L L L N°	
5 DEMANDEUR	R (Cochez l'une des 2 cases):		
Nom ou dénominati	ion sociale	BIOMERIEUX	
Prénoms			
Forme juridiqu	<u>ie</u>	Société anonyme	
N° SIREN		[411759541218]	
Code APE-NAF		714111	
Domicile [*]	Rue	Chemin de l'Orme	
ou siège	Code postal et ville	[6:9:2:8:0] MARCY L'ETOILE	
31050	Pays	FRANCE	<u>.</u>
Nationalité		FRANCAISE	3.
N° de téléphor	ne facultatif		
Nº de télécopi			1.25
	onique (facultatif)		
DEMANDEUR	t (Cochez l'une des 2 cases)	Personne morale Personne physique	
Nom ou dénominati	ion sociale		
Prénoms			
Forme juridiqu	ie		
N° SIREN			
Code APE-NAF	γ-		···
Domicile ou	Rue		
siège	Code postal et ville		
	Pays		
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)			
SIGMATURE DOUBLE DOUBLE OU DU MAN (Nom et quali	IDATAIRE lité du signataire)	10206 VISA DE LA PRÉFEC OU DE L'INPI Carol WALIGORSKI Et du service Propriété Industrielle	TURE

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

Le domaine technique de l'invention est celui des microsystèmes dans lesquels des microactionneurs sont destinés à remplir des fonctions mécaniques, chimiques, électriques, thermiques ou fluidiques, pour applications microélectroniques comme les puces, ou biomédicales comme les cartes d'analyse intégrant la microfluidique de synthèse ou. chimique comme les microréacteurs.

Les microactionneurs sont des objets miniaturisés, ayant des dimensions de l'ordre du millimètre. Ils sont réalisés dans des supports solides pouvant être semi-conducteurs ou isolants, dans le but de former des microsystèmes comme, par exemple, des microvannes ou des micropompes dans des microcircuits de fluide, ou des microinterrupteurs dans des microcircuits électroniques.

10

15

20

25

30

35

microactionneurs utilisant des électrostatique, piézoélectrique, électromagnétique et bimétallique existent depuis quelques temps déjà. Une nouvelle génération de microactionneurs commence à faire son apparition: ceux utilisant l'effet pyrotechnique. Les matériaux pyrotechniques ont une densité énergétique élevée, leur utilisation dans des microactionneurs permet donc de réduire considérablement la dimension des microsystèmes intégrant de tels microactionneurs. tels microactionneurs pyrotechniques sont par décrits dans la demande de brevet WO 02/088551.

Dans cette demande de brevet, le fonctionnement d'un microactionneur pyrotechnique est obtenu provoquant la combustion d'une micro-charge pyrotechnique, généralement en élevant localement température jusqu'à un seuil de décomposition au moyen d'un dispositif d'initiation. Les gaz générés par la combustion de la micro-charge pyrotechnique ont un effet déterminé. Cet effet peut consister par exemple comme dans la demande précitée à déformer une délimitant la chambre de combustion de la micro-charge

pyrotechnique. Dans un microsystème déterminé, comme par exemple dans une microvanne, cette membrane, en se déformant, aura par exemple pour fonction de venir fermer un circuit de fluide entre deux canalisations. Dans un microsystème, le nombre de microactionneurs utilisés peut être très élevé et atteindre plusieurs centaines.

général, la micro-charge pyrotechnique placée en contact avec des moyens d'initiation. C'est le cas dans la demande de brevet précitée n°WO 02/088551 mais également dans le cas de la demande de brevet WO 98/22719. Dans cette demande WO 98/22719, la microcharge pyrotechnique est déposée entre deux contacts métalliques sur un support d'un circuit imprimé par lequel est amené le courant d'initiation de la charge pyrotechnique. Une résistance de surface moins étendue que celle de la charge est déposée sur la pyrotechnique à initier et relie les deux contacts métalliques.

10

15

20

25

30

35

Pour un fonctionnement correct d'un microactionneur ou d'un microsystème, on s'est aperçu que la quantité de matériau pyrotechnique brûlée lors du fonctionnement doit être maîtrisée. Cela peut évidemment s'obtenir en maîtrisant, d'une part, la quantité de pyrotechnique utilisée et d'autre part le positionnement dépôt pyrotechnique par rapport aux moyens d'initiation. Cependant, la maîtrise de deux paramètres peut s'avérer difficile et contraignante notamment dans le cas οù les microsystèmes fabriqués industriellement à haute cadence. En effet, le positionnement des dépôts sur leur support notamment des tolérances de réalisation du support, des tolérances de positionnement de ce support sur machine de dépose et des tolérances de la machine elle-Sur des objets miniaturisés, tels microsystèmes, un écart dans le positionnement de la

matière pyrotechnique par rapport à son moyen d'initiation peut entraîner un dysfonctionnement.

Un but de l'invention est de pouvoir s'affranchir des difficultés et contraintes dans la fabrication d'un microsystème disposant de plusieurs dépôts de matière pyrotechnique.

5

10

15

20

25

30

35

est atteint Ce but par un microsystème pyrotechnique comportant un substrat présentant au moins deux zones d'initiation électriques distinctes d'un matériau pyrotechnique déposé sur le substrat, microsystème étant caractérisé en ce qu'un même dépôt de pyrotechnique matériau recouvre les deux zones d'initiation, ledit dépôt, réalisé sur le substrat, à une épaisseur suffisamment faible pour l'initiation du matériau en une zone d'initiation reste localisée et ne se propage pas jusqu'à l'autre zone d'initiation, mais suffisante pour générer une quantité de gaz déterminée.

Selon l'invention, la contrainte de devoir obtenir un dépôt parfaitement localisé au niveau de la zone d'initiation est donc éliminée. La production industrielle pourra donc être facilitée et sera moins dépendante des diverses tolérances des machines intervenant dans la fabrication.

Selon une particularité, le dépôt de matériau pyrotechnique est réalisé à une épaisseur inférieure à $100\mu m$. Avec une telle épaisseur, le matériau pyrotechnique peut être déposé en couche entière et la combustion autour d'une zone d'initiation sur ce dépôt ne se propage pas au-delà, jusqu'à la zone d'initiation adjacente.

Selon une autre particularité, le substrat est réalisé à partir d'un assemblage de couches superposées.

Selon une autre particularité, le dépôt de matériau pyrotechnique constitue l'une des couches superposées. Selon l'invention, la production industrielle d'un tel

microsystème se trouve facilitée car il suffit de superposer des couches successives. Les contraintes de positionnement du dépôt pyrotechnique par rapport aux différentes zones d'initiation sont fortement réduites.

Selon une autre particularité, le dépôt de matériau pyrotechnique sert d'adhésif pour l'assemblage entre une couche située au-dessus dudit dépôt et une couche située au-dessous dudit dépôt.

5

20

25

30

Selon une autre particularité, le matériau 10 pyrotechnique déposé se présente sous la forme d'un vernis à base de nitrocellulose.

Selon une autre particularité, le vernis est déposé à une épaisseur comprise, après séchage, entre 5 et $40\mu\mathrm{m}.$

Selon une autre particularité, chacune des zones d'initiation peut être réalisée à partir d'une résistance électrique sur le substrat.

Selon une autre particularité, chacune des zones d'initiation peut être réalisée au niveau du point de contact d'un doigt conducteur, relié à un générateur électrique, sur le substrat en matière métallique également relié audit générateur.

Selon une autre particularité, le microsystème comporte une membrane déformable délimitant partiellement une chambre de combustion destinée à recevoir les gaz générés par au moins une partie du dépôt de matériau pyrotechnique en contact avec l'une des zones d'initiation.

Selon une autre particularité, le microsystème comprend une couche à travers laquelle est formé un orifice formant la chambre de combustion, ladite couche étant prise entre la membrane, formant elle-même une couche, et le dépôt de matériau pyrotechnique.

Un autre but de l'invention est de proposer un procédé de fabrication d'un microsystème tel que celui présenté ci-dessus.

Ce but est atteint par un procédé de fabrication d'un microsystème comportant une pluralité microactionneurs pyrotechniques adjacents établis sur un substrat, chaque microactionneur étant apte à avoir un effet déterminé grâce aux gaz générés par la combustion d'un matériau pyrotechnique initié à partir d'une zone d'initiation électrique associée microactionneur, caractérisé en ce qu'une couche d'un pyrotechnique matériau commune à tous les microactionneurs est déposée sur le substrat à une épaisseur suffisamment faible pour que l'initiation du matériau pyrotechnique en une zone d'initiation reste localisée et ne se propage pas jusqu'à une autre zone d'initiation, mais suffisante pour générer une quantité de gaz déterminée.

Selon une particularité, le procédé consiste uniquement en un empilement de couches superposées, la couche de matériau pyrotechnique constituant l'une des couches de l'empilement.

Selon une autre particularité, la couche de matériau pyrotechnique est déposée à une épaisseur inférieure à $100\mu\mathrm{m}$.

Selon une autre particularité, la couche de matériau pyrotechnique est déposée par enduction, sérigraphie, tampographie, trempage ou par pulvérisation.

30

5

10

15

20

25

L'invention, avec ses caractéristiques et avantages, ressortira plus clairement à la lecture de la description faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 représente schématiquement, en coupe axiale longitudinale, un microactionneur.

La figure 2 représente schématiquement, en coupe axiale longitudinale, une microvanne dans laquelle un microactionneur permet de réaliser un cycle de fermeture/ouverture du circuit fluidique.

La figure 3 représente schématiquement une microvanne selon un autre mode de réalisation.

La figure 4 représente schématiquement, en coupe axiale longitudinale, un microsystème composé d'une pluralité de microactionneurs sur lequel vient s'adapter un dispositif d'initiation électrique.

Dans l'ensemble de la description, les expressions "matière pyrotechnique" et "matériau pyrotechnique" ont la même signification.

15

20

25

30

35

10

5

L'invention va à présent être décrite en liaison avec les figures 1 à 4.

4

En référence à la figure 1, un microactionneur 1 pyrotechnique comprend typiquement une chambre 2 par exemple de forme cylindrique réalisée dans un support en polycarbonate. Ledit support résulte par exemple comme représenté en figure 1 d'un empilement de feuilles ou couches assemblées les unes sur les autres, par exemple par collage, soudage par par laser ou par thermocompression, par laminage à chaud ou par tout approprié. moyen Un microactionneur pyrotechnique simple tel que celui représenté en fiqure 1 comporte trois couches 10, 11, 12 superposées. La couche centrale 10 est percée transversalement d'un trou qui est recouvert par la couche dite supérieure 12 fixée sur une première face de la couche centrale et dite face supérieure 100 et par la couche dite couche inférieure 11 fixée sur la face opposée à la face supérieure 100 de la couche centrale 10, dite face inférieure 101. Les parois latérales de ce trou délimitent donc, avec la couche supérieure 12 et la couche inférieure 11,

chambre 2 dite de combustion. Le diamètre de la chambre 2 de combustion ainsi formée est par exemple de 1 mm. Dans cette chambre 2 de combustion est placée une microcharge 3 pyrotechnique. Préférentiellement, la chambre 2 définit un espace hermétique.

couche supérieure 12 est constituée d'une membrane déformable assemblée sur la face supérieure 100 couche centrale 10. Cette membrane exemple matériau plastique et/ou élastique, en exemple en PTFE Téflon, (ou margue déposée), en caoutchouc, en élastomère, en PVDC (Polychlorure de vinylidène) ou PVDF (Polyfluorure de vinylidène).

10

15

20

25

30

Selon l'invention, la micro-charge 3 pyrotechnique est déposée dans la chambre 2 de combustion sur la face de la couche inférieure 11 qui est en contact avec la couche centrale 10. Cette face de la couche 11 conductrice est dite face supérieure 110. La micro-charge 3 pyrotechnique peut être déposée par exemple sous la forme d'un film par exemple discoïde ayant une épaisseur comprise entre 1 μ m et 100 μ m.

Le mode de fonctionnement de ce microactionneur 1 est le suivant. Un courant électrique est délivré dans moyen d'initiation formant une zone d'initiation constituée par exemple d'une piste conductrice chauffante présentant une partie résistive ou d'un fil résistif chauffant. La température dans d'initiation s'élève jusqu'à atteindre la température d'inflammation de la composition pyrotechnique combustion de ladite composition 3 entraîne la production de gaz ce qui crée une surpression dans la chambre 2. La membrane 12 qui est ainsi sollicitée réagit en se déformant.

La figure 2 représente un microactionneur 7 35 amélioré permettant d'obtenir une déformation de la membrane comme décrit ci-dessus en référence à la figure

1 et également une réduction de cette déformation. Sur les figures 2 et 3, ce microactionneur 7 joue le rôle d'une microvanne dans un microcircuit de fluide. microactionneur 7 est constitué quatre de superposées 71, 72, 73 et 74, dite respectivement première couche, deuxième couche, troisième couche et quatrième couche. Les deuxième, troisième et quatrième couches 72, 73, 74 constituent le support et sont par exemple en polycarbonate. La première couche 71 est en matériau plastique et/ou élastique, par exemple téflon (marque déposée), en latex, en PVDC (Polychlorure de vinylidène) ou PVDF (Polyfluorure de vinylidène). Sur la première couche 71 du microactionneur 7 est présente une cinquième couche 75 constituant le microcircuit de fluide. Cette cinquième couche 75 constituée par microcircuit de fluide est traversée transversalement par deux canalisations 750 et 751. Les canalisations 750 et 751 comportent une extrémité débouchant dans un évidement 752 formé sur la face 753 de cette cinquième couche 75, dite face inférieure, en vis-à-vis de la première couche 71 microactionneur 7. Les deux canalisations 750 et communiquent donc par l'intermédiaire de l'évidement 752. Une première canalisation 750 constitue par exemple arrivée de fluide vers l'évidement 752 deuxième canalisation 751 constitue une sortie de fluide hors de l'évidement 752. L'ensemble du microactionneur 7 et du microcircuit de fluide forme un microsystème.

10

15

20

25

La première couche 71 du microactionneur constitue une membrane 710 déformable telle que celle 30 décrite sous la référence 12 à la figure 1. La membrane 710 étant fixée sur la face inférieure 753 cinquième couche 75, par exemple par collage, déformation de la membrane 710 n'est possible que dans l'évidement 752 de la cinquième couche 75. 35

La deuxième couche 72 est constituée d'une feuille percée transversalement de deux trous et d'épaisseur par exemple égale à 0,5 mm. Les parois latérales d'un premier trou délimitent avec la première couche 71 située au-dessus et avec la troisième couche 73 située au-dessous, la chambre 720 de combustion principale du microactionneur.

La chambre principale 720 aura par exemple un diamètre de 1 mm. Les parois latérales d'un deuxième trou délimitent avec la première couche 71 située audessus et avec la troisième couche 73 située au-dessous une chambre secondaire ou réservoir 722 dont le rôle sera explicité ci-dessous. Cette chambre secondaire 722 aura par exemple un diamètre égal à 2 mm.

10

15 La troisième couche 73 est constituée d'une feuille à travers laquelle est formée une canalisation 730 en forme de U dont chacune des extrémités débouche dans une des chambres 720 et 722 de la deuxième couche 72. Cette canalisation 730 est constituée d'un canal 733 creusé sur la face de la troisième couche 73 située en vis-à-20 de la quatrième couche 74 et recouvert par quatrième couche 74 du microactionneur 7. extrémité du canal 733 se prolonge perpendiculairement par un conduit 731 et 732, chacun des conduits 731 et débouchant dans une chambre 25 732 720 et 722 deuxième couche 72 du microactionneur. Cette quatrième couche 74 est constituée d'un film d'étanchéité recouvrant la canalisation 730.

Selon l'invention, un dépôt 721 de matière pyrotechnique est réalisé dans la chambre de combustion principale 720 sur la face supérieure de la troisième couche 73. Ce dépôt 721 de matière pyrotechnique obture donc le conduit 731 de la canalisation 730 formée dans la troisième couche 73. Selon l'invention, on a remarqué qu'avec une épaisseur de dépôt suffisamment faible mais suffisante pour générer la quantité de gaz souhaitée, la

combustion du matériau pyrotechnique se limitait à une zone réduite située autour du point d'initiation. De ce fait, un même dépôt de matière pyrotechnique peut être initié à plusieurs endroits distincts et à des moments différents pour générer plusieurs fois dans la chambre de combustion une quantité de gaz nécessaire pour obtenir un effet déterminé. Par conséquent, en référence à la figure 2, le dépôt 721 de matière pyrotechnique réalisé dans la chambre de combustion principale 720 sur toute la surface de la face supérieure de la troisième couche 73 pourra par exemple être initié à deux endroits distincts.

5

10

15

20

25

30

35

Selon l'invention, l'initiation en deux points ou zones du dépôt 721 de matière pyrotechnique peut être réalisée à l'aide de moyens différents. L'un de ces moyens consiste par exemple à utiliser un fil résistif chauffant sur lequel est déposé le matériau pyrotechnique. Un autre de ces moyens consiste exemple à utiliser des pistes d'initiation déposées par exemple par sérigraphie sur la face supérieure 734 de la troisième couche 73. La piste comporte alors une partie résistive constituant une zone d'initiation par laquelle se produit l'initiation.

4

٠, نو

Une microvanne telle que représentée en figure 2 fonctionne donc de la manière suivante. Un courant électrique est délivré dans un fil résistif chauffant ou une partie résistive d'une piste conductrice jusqu'à ce que la température atteinte soit suffisante l'inflammation d'une première partie du dépôt 721 matériau pyrotechnique. Selon l'invention, l'épaisseur de dépôt 721 étant suffisamment faible, l'inflammation du dépôt 721 reste localisée et ne se répand pas l'ensemble du dépôt 721 de matière pyrotechnique. Selon l'invention, le dépôt 721 est brûlé sur une différente de celle permettant l'obturation de canalisation 730 d'évacuation, de manière à ce que les

produits restent dans la chambre de combustion principale 720. La combustion de cette première partie du dépôt pyrotechnique 721 entraîne la production de gaz dans la chambre de combustion principale 720 de manière à créer une surpression dans cette chambre 720. surpression dans la chambre 720 entraîne la déformation de la membrane 710. La déformation de la membrane 710, en réponse à la pression des gaz, n'est possible qu'en direction de l'évidement 752 formé dans la cinquième couche 75. La membrane vient donc se déformer jusqu'à venir se plaquer au fond de l'évidement 752 et ainsi s'interposer entre les deux canalisations 750 et 751 du microcircuit de fluide. Le microcircuit de fluide est donc fermé et cette fermeture est maintenue grâce à la pression des gaz contenus dans la chambre principale 720 sur la membrane 710 déformable. La pression des gaz contenus dans la chambre principale 720 est suffisante pour plaquer la membrane 710 au fond de l'évidement 752 supérieure à la contre-pression exercée membrane 710 par le fluide contenu dans le microcircuit de manière à maintenir la membrane 710 au fond de l'évidement 752.

10

15

20

Une deuxième partie du dépôt 721 pyrotechnique non obture donc toujours le conduit 731 canalisation 730 reliant les deux chambres 720 et 722. 25 La combustion de cette deuxième partie du dépôt 721 pyrotechnique, provoquée par des moyens d'initiation du type de ceux présentés ci-dessus, c'est-à-dire un fil chauffant ou la partie résistive d'une piste conductrice 30 d'initiation, permet de dégager l'entrée canalisation 730 reliant les deux chambres 720 et 722. La chambre secondaire 722 étant à une pression inférieure à la pression régnant dans la chambre principale 720, les gaz générés par la combustion de la première partie du dépôt 721 pyrotechnique ainsi que par 35 la combustion de cette deuxième partie du dépôt 721

obturant la canalisation 730 peuvent se répandre par la canalisation 730 dans la chambre secondaire 722. volume de la chambre secondaire 722 est suffisant pour obtenir une pression des gaz entre les deux chambres 720, 722 qui est inférieure à la contre-pression exercée la membrane 710 par le fluide compris dans microcircuit. Ainsi, lors de la détente des provoquée par l'ouverture de la canalisation, on obtient une réduction de la déformation de la membrane 710 suffisante pour libérer les orifices formés par canalisations 750, 751 du microcircuit de fluide. Cette déformation de la membrane 710, vers l'extérieur l'évidement 752, provoque l'ouverture de la vanne donc la mise en communication des deux canalisations 750 et 751 du microcircuit de fluide.

10

15

20

25

30

35

Selon une variante de réalisation, il serait également possible de purger les gaz contenus dans la chambre principale 720 directement vers l'extérieur du dispositif en mettant la chambre principale 720 en communication avec l'air libre. Selon cette variante, puisque tous les gaz sont évacués de la chambre principale 720, la membrane 710, si elle est élastique, revient dans sa position initiale.

Selon un autre mode de réalisation représenté en figure 3, le dépôt 721' de matériau pyrotechnique est réalisé sur toute la surface de la face supérieure de la troisième couche 73. Le dépôt 721' de pyrotechnique constitue donc une couche à part entière située entre la deuxième couche 72 et la troisième couche 73. Selon l'invention, l'initiation en différents points de cette couche pyrotechnique est donc possible. Comme décrit ci-dessus, une première initiation permet de déformer la membrane 710 dans un sens tandis qu'une autre initiation à l'entrée et à la sortie canalisation permet l'évacuation des gaz vers la chambre secondaire 722 et la déformation de la membrane 710 dans

l'autre sens. Enfin, l'initiation d'une autre partie de la couche de matière pyrotechnique dans une zone située par exemple dans la chambre de combustion principale 720 chambre secondaire 722 permet d'obtenir une nouvelle surpression dans les chambres principale 720 et secondaire 722 et ainsi une nouvelle déformation de la membrane 710. Il est ainsi possible de réaliser un cycle fermeture/ouverture/fermeture du circuit de fluide.

Un microsystème est un dispositif multifonctionnel 10 miniaturisé dont les dimensions maximales n'excèdent pas quelques millimètres. Dans le cadre d'un microcircuit de fluide, un microsystème peut, par exemple, être une microvanne ou une micropompe, et dans le cadre d'un microcircuit électronique, un microinterrupteur ou un 15 microcommutateur.

En référence à la figure 4, un microsystème 1', se par exemple sous la forme d'une carte, comporte une pluralité de microactionneurs (1a,...,1h) adjacents identiques à celui décrit en référence à la 20 figure 1. Ces microactionneurs (1a,...,1h) formés dans un même support par l'empilement des trois couches 10, 11, 12 définies ci-dessus, c'est-à-dire par une couche centrale 10 prise entre une membrane formant la couche supérieure 12 et une couche inférieure 11. La 25 chambre (2a, ..., 2h)de combustion de chacun microactionneurs (la,...,lh) est donc délimitée par les parois latérales d'un trou formé à travers la couche 10 centrale et par la couche supérieure 12 formant membrane déformable située au-dessus et la couche inférieure 11 située au-dessous.

l'invention, à la différence du microactionneur présenté en figure 1, une micro-charge pyrotechnique n'est pas déposée dans chacune chambres (2a,...,2h) de combustion des microactionneurs (la,...,lh). Selon l'invention, le dépôt 13 de matière

30

35

pyrotechnique permettant de gonfler la membrane 12 au niveau de chacun des microactionneurs (1a,...,1h) est commun à tous les microactionneurs (la,...,lh). Selon l'invention, un tel dépôt 13 pyrotechnique représente une couche unique 13 située entre la couche centrale 10 et la couche inférieure 11. Selon l'invention, donné que la combustion du dépôt 13 est localisée et ne se propage pas à tout le dépôt 13, l'initiation peut donc être effectuée en différents points de la couche et à des instants différents. A partir de la même couche 13 matière pyrotechnique commune à tous microactionneurs (1a, ..., 1h), il est possible indifféremment d'actionner chacun de ces microactionneurs (1a,...,1h). Pour cela, l'épaisseur du dépôt 13 de matière pyrotechnique doit être suffisamment faible afin d'éviter que, dans une chambre (2a,...,2h) combustion d'un microactionneur (1a, ..., 1h), combustion se propage au-delà d'une certaine zone provoque la mise sous pression de la chambre combustion d'un microactionneur adjacent. La combustion du dépôt ne doit donc pas se propager au-delà de la chambre (2a,...,2h) de combustion du microactionneur qui a été activé.

10

15

20

Le microsystème 1' représenté en figure 4 utilise 25 exemple un dispositif d'initiation particulier comportant plusieurs doigts (6a,...,6h) conducteurs identiques se dressant parallèlement entre eux perpendiculairement à un plan défini sur un élément 9 support. Chacun de ces doigts (6a,...,6h) est monté sur 30 un ressort (7a,...,7h) et relié électriquement à une centrale 8 de commande. Les axes des ressorts (7a, ..., 7h)sont parallèles entre eux perpendiculaires au plan défini sur l'élément 9 support. Les doigts (6a,...,6h) sont reliés électriquement en 35 parallèle à une borne d'une source 4 de courant de la centrale 8 de commande. La centrale 8 commande une

pluralité d'interrupteurs (5a,...,5h), chaque (6a,...,6h) conducteur étant associé à l'un de ces interrupteurs (5a, ..., 5h). Ainsi la centrale commande peut, en fermant certains interrupteurs (5a, ..., 5h), sélectionner les microactionneurs (1a, ..., 1h)à activer. La centrale 8 de commande comporte donc des moyens de sélection lui permettant de sélectionner les interrupteurs à fermer en fonction des microactionneurs (1a, ..., 1h)qu'il est nécessaire d'activer. Selon l'invention, l'élément 9 support vient 10 s'adapter sur le microsystème 1' de sorte qu'un doigt (6a,...,6h) conducteur soit associé à chaque microactionneur (la,...,lh) du microsystème l'. Lorsque l'élément 9 support est adapté sur le microsystème 1', les doigts (6a,...,6h) conducteurs sont maintenus en 15 contact avec la couche inférieure 11 du microsystème 1', chacun à l'aide de leur ressort (7a,...,7h). Les doigts (6a,...,6h) conducteurs sont placés sur l'élément 9 support de manière à venir chacun au contact de la face inférieure 111 de la couche inférieure 11, juste au-20 dessous de la chambre (2a,...,2h) de combustion d'un microactionneur (1a, ..., 1h). L'élément comporte par exemple une couronne 90 périphérique lui permettant de venir s'adapter sur le microsystème 1'. L'assemblage entre les deux éléments est effectué par 25 exemple suivant les flèches représentées sur la figure 4 et la liaison entre le microsystème 1' et l'élément 9 support pourra être réalisée par exemple par clipsage.

Selon l'invention, la centrale 8 de commande pourra 30 être intégrée à l'élément 9 support de manière à constituer un dispositif d'initiation complet adaptable sur le microsystème 1'.

Selon l'invention, la couche inférieure 11 est une couche conductrice de l'électricité. La couche 13 de 35 matière pyrotechnique est déposée sur la face supérieure 110 de la couche inférieure conductrice. Chaque doigt

(6a,...,6h) conducteur, en contact avec la inférieure 11 conductrice, lorsqu'il est sélectionné par centrale 8 de commande, permet de échauffement localisé de la couche inférieure 11 conductrice et de provoquer l'initiation de la partie du dépôt 13 de matière pyrotechnique située juste au-dessus du doigt pour obtenir ainsi, sous l'action des gaz combustion, la déformation ponctuelle, au niveau microactionneur (la,...,lh) sélectionné et activé, de la couche supérieure 12 formant la membrane.

10

15

20

25

30

35

Selon l'invention, dans les différents modes de réalisation décrits ci-dessus, la présence des parois latérales d'une chambre (2a,...,2h, 720) de combustion peut favoriser l'extinction du dépôt 13 autour de la zone d'initiation et permettre la non-propagation de la combustion du dépôt aux chambres (2a,...,2h, 722) de combustion adjacentes.

Le dépôt matière pyrotechnique effectué uniquement dans la chambre de combustion principale 720 (721, figure 1) ou effectué en couche complète (721', figure 2 ou 13, figure 4) peut être réalisé à une épaisseur inférieure à $100\mu m$. L'épaisseur de dépôt 721, 721', 13 doit être suffisamment faible pour éviter que la combustion ne se propage au-delà d'une zone limitée située autour de la zone d'initiation. Cependant, cette épaisseur de dépôt 721, 721', 13 doit être suffisante pour générer la quantité de gaz nécessaire à l'obtention de l'effet désiré. La quantité de gaz générée dépend en outre notamment du pouvoir énergétique du matériau pyrotechnique utilisé, ainsi que de la géométrie du dispositif d'initiation. La quantité de gaz dégagée est donc maîtrisée en jouant sur l'épaisseur du dépôt de matière pyrotechnique, sur la nature du matériau pyrotechnique utilisé ainsi que sur la géométrie du dispositif d'initiation. Plus le pouvoir énergétique du

matériau est grand, plus l'épaisseur de dépôt pourra être réduite. De plus, selon la géométrie du dispositif d'initiation, une surface plus ou moins grande du dépôt de la matière pyrotechnique peut être initiée, ce qui permet de générer plus ou moins de gaz.

Le matériau pyrotechnique utilisé pour le dépôt peut être un vernis à base de nitrocellulose. Dans ce cas, l'épaisseur du dépôt pour faire fonctionner un microactionneur du type de celui de la figure 1 ou 2 pourra être comprise, après séchage, entre 5 et 40μ m et préférentiellement entre 10 et 20μ m.

10

Selon l'invention, le dépôt en couche sur l'ensemble d'un support peut être effectué par diverses techniques comme par exemple l'enduction, la 15 sérigraphie, la tampographie, le trempage la pulvérisation. Les vernis à base de nitrocellulose ont en particulier des propriétés filmogènes bien adaptées à l'enduction sur un support déterminé.

Selon l'invention, dans le cas de la figure 3 ou de la figure 4, la couche 721', 13 de matière pyrotechnique peut avoir une fonction adhésive permettant ou facilitant l'assemblage entre la couche située au-dessus 72, 10 et la couche située au-dessous 73, 11.

Revendications

1. Microsystème (7, 1') pyrotechnique comportant un substrat présentant au moins deux zones d'initiation électriques distinctes d'un matériau pyrotechnique déposé sur le substrat, caractérisé en ce qu'un même dépôt (721, 721', 13) de matériau pyrotechnique recouvre les deux zones d'initiation, ledit dépôt (721, 721', 13), réalisé sur le substrat, étant à une épaisseur suffisamment faible pour que l'initiation du matériau pyrotechnique au niveau d'une zone d'initiation reste localisée et ne se propage pas jusqu'à l'autre zone d'initiation, mais suffisante pour générer une quantité de gaz déterminée.

15

10

2. Microsystème (7, 1') selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dépôt (721, 721', 13) de matériau pyrotechnique est réalisé à une épaisseur inférieure à $100\mu m$.

20

3. Microsystème (7, 1') selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le substrat est réalisé à partir d'un assemblage de couches (71, 72, 73, 74 et 10, 11, 12) superposées.

25

4. Microsystème (7, 1') selon la revendication 3, caractérisé en ce que le dépôt (721', 13) de matériau pyrotechnique constitue l'une des couches (71, 72, 73, 74 et 10, 11, 12) superposées.

30

35

5. Microsystème (7, 1') selon la revendication 4, caractérisé en ce que le dépôt (721', 13) de matériau pyrotechnique sert d'adhésif pour l'assemblage entre une couche située au-dessus (72, 10) dudit dépôt (721', 13) et une couche située au-dessous (73, 11) dudit dépôt (721', 13).

- 6. Microsystème (7, 1') selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau pyrotechnique déposé se présente sous la forme d'un vernis à base de nitrocellulose.
- 7. Microsystème (7, 1') selon la revendication 6, caractérisé en ce que le vernis est déposé à une épaisseur comprise après séchage entre 5 et 40µm
- 8. Microsystème (7, 1') selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacune des zones d'initiation peut être réalisée à partir d'une résistance électrique sur le substrat.

10

15

30

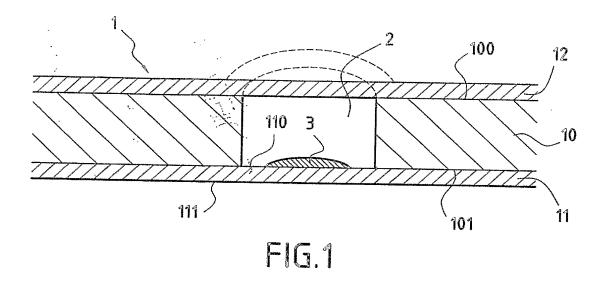
35

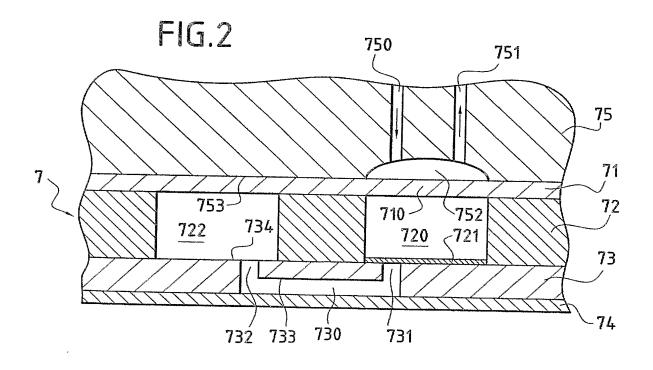
- 9. Microsystème (7, 1') selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacune des zones d'initiation peut être réalisée au niveau du point de contact d'un doigt (6a,...,6h) conducteur, relié à un générateur (4) électrique, sur le substrat en matière métallique également relié audit générateur (4).
- 10. Microsystème (7, 1') selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte une membrane (710, 12) déformable délimitant partiellement une chambre de combustion (720, 2a,...,2h) destinée à recevoir les gaz générés par au moins une partie du dépôt (721, 721', 13) de matériau pyrotechnique en contact avec l'une des zones d'initiation.
 - 11. Microsystème (7, 1') selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend une couche (72, 10) à travers laquelle est formé un orifice formant la chambre (720, 2a,...,2h) de combustion, ladite couche (72, 10) étant prise entre la membrane (710, 12), formant elle-

même une couche, et le dépôt de matière pyrotechnique (721', 13).

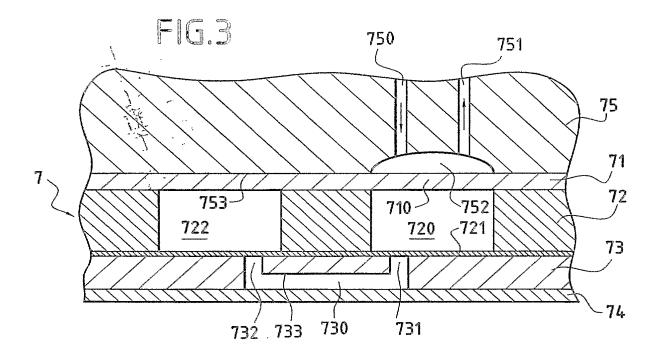
- Procédé đe fabrication d'un microsystème comportant une pluralité de microactionneurs (la,...,lh) 5 pyrotechniques adjacents établis sur un substrat, chaque microactionneur (la,...,lh) étant apte à avoir un effet déterminé grâce aux gaz générés par la combustion d'un matériau pyrotechnique initié à partir d'une 10 d'initiation électrique associée à chaque microactionneur (1a,...,1h), caractérisé en ce qu'une couche (13) de matériau pyrotechnique, commune à tous les microactionneurs (1a,...,1h), est déposée sur substrat à une épaisseur suffisamment faible pour que l'initiation de la matière pyrotechnique en une zone 15 d'initiation reste localisée et ne se propage jusqu'à l'autre zone d'initiation, mais suffisante pour générer une quantité de gaz déterminée.
- 20 13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il consiste uniquement en un empilement de couches (10, 11, 12) superposées, la couche (13) de matériau pyrotechnique constituant l'une des couches de l'empilement.
 - 14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce que la couche (13) de matériau pyrotechnique est déposée à une épaisseur inférieure à $100\mu m$.
- 15. Procédé selon l'une des revendications 12 à 14, caractérisé en ce que la couche (13) de matériau pyrotechnique est déposée par enduction, sérigraphie, tampographie, trempage ou par pulvérisation

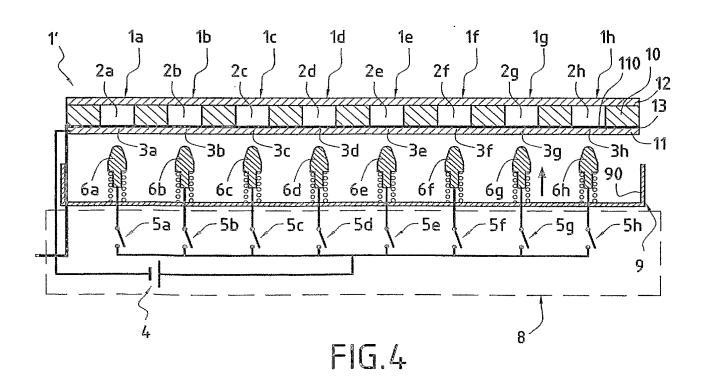
25





2/2







BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

(DIN Tradigo) 0 825 83 85 87

(JIB & TTC/mn

Télécopie: 33 (0)1 53 04 52 65

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes) Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos rérérences pour ce dossier (facultatif)	B. 1235
THE PARTITION OF THE PA	0410 20

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Microsystème pyrotechnique et procédé de fabrication d'un microsystème.

LE(S) DEMANDEUR(S):

SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES 12 Quai Henri IV 75004 PARIS FRANCE

BIOMERIEUX Chemin de l'Orme 69280 MARCY L'ETOILE FRANCE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):

The same of the sa		
Nom		BROYER
Prénoms		Patrick
Adresse	Rue	Le Parc du Ferrier Rue des Maires André
	Code postal et ville	[0 1 7 0 0] BEYNOST
Société d'a	appartenance (facultatif)	
2 Nom		COLIN
Prénoms		Bruno
Adresse	Rue	23 Chemin des Garennes
	Code postal et ville	[6.19121810] MARCY L'ETOILE
Société d'a	ppartenance (facultatif)	CELEVICIO III III III III III III III III III
₹ Nom		ROLLER
Prénoms		Denis
Adresse	Rue	9 Villa du Gamay
	Code postal et ville	19 11 15 19 10 J LA FERTE ALAIS
Société d'appartenance (facultatif)		ETTOTOTO TO ENTENENTO
C'il v o mive	do trais income	

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE

(Nom et qualité du signataire)

P.G. 10206

22 janvier 2004

Carol WALIGORSKI

Chef du service Propriété Industrielle

